

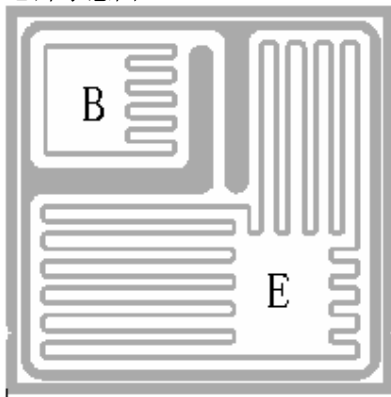
PD1.65

硅 PNP 外延平面晶体管芯片 (4")

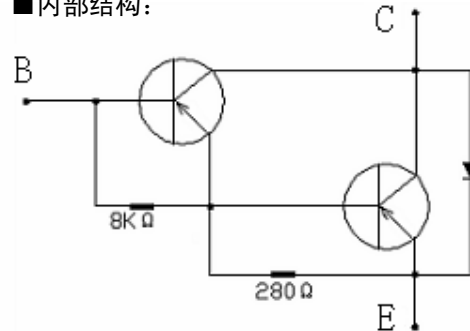
■用途

- * 电源调整管
- * 音频功率放大器
- * 其他电子电路

■芯片示意图



■内部结构:



■芯片结构

芯片尺寸	1650 μm × 1650 μm
压焊区尺寸	基区 350 μm × 430 μm 发射区 380 μm × 500 μm
锯片槽宽度	90 μm
芯片厚度	240 ± 10 μm
金属层	正面: Al 3.1 ± 0.4 μm 背面: Ag 1.4 ± 0.2 μm

■电特性(Ta=25℃)

参数名称	符号	测试条件	典型值	最小值	最大值	单位
集电极--基极击穿电压	BV_{CBO}	$I_C = -0.1mA, I_E = 0$	-160	-100		V
集电极--发射极击穿电压	BV_{CEO}	$I_C = -10mA, I_B = 0$	-140	-100		V
集电极--发射极维持电压	$V_{CEO(sus)}^*$	$I_C = -30mA, I_B = 0$		-100		V
发射极--基极击穿电压	BV_{EBO}	$I_B = -2.5mA, I_C = 0$		-8		V
集电极--基极截止电流	I_{CBO}	$V_{CB} = -100V, I_E = 0$			-1	μA
集电极-发射极截止电流	I_{CEO}	$V_{CE} = 100V, I_B = 0$			-2	μA
发射极--基极截止电流	I_{EBO}	$V_{EB} = -10V, I_C = 0$	-2.5		-3.5	mA
直流电流增益	h_{FE1}	$V_{CE} = -3V, I_C = 0.5A$		850	15000	
直流电流增益	h_{FE2}	$V_{CE} = -3V, I_C = -2A$	4000	2000	15000	
集电极--发射极饱和电压	V_{CES}	$I_C = -3A, I_B = -12mA$	-1.3		-1.8	V

* $V_{CEO(sus)}$: 脉宽 ≤ 300 μs, 占空比 ≤ 2% (TO-220)